

描述 / Descriptions

TO-220F 塑封封装 PNP 半导体三极管。Silicon PNP transistor in a TO-220F Plastic Package.

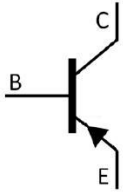
特征 / Features

特征频率高,与 3DA4793 互补。
High transition frequency, complementary to 3DA4793.

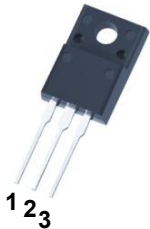
用途 / Applications

用于一般功率放大和驱动级放大。
Power amplifier, driver stage amplifier applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Base PIN 2 : Collector PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。See Marking Instructions.

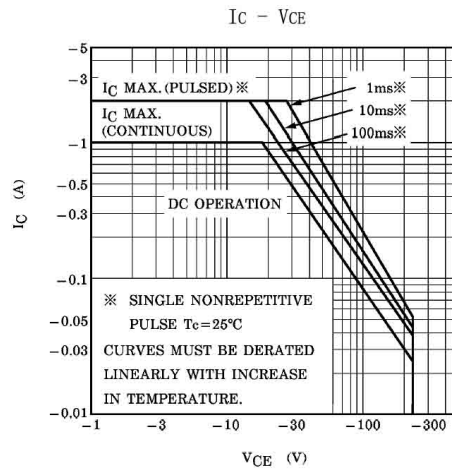
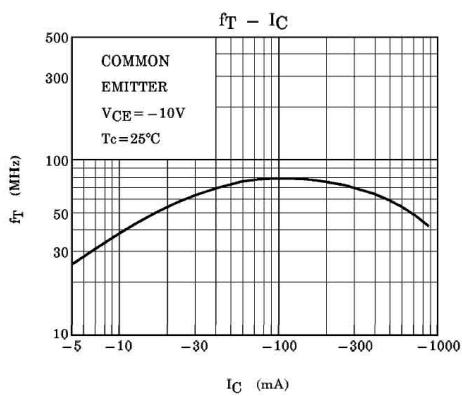
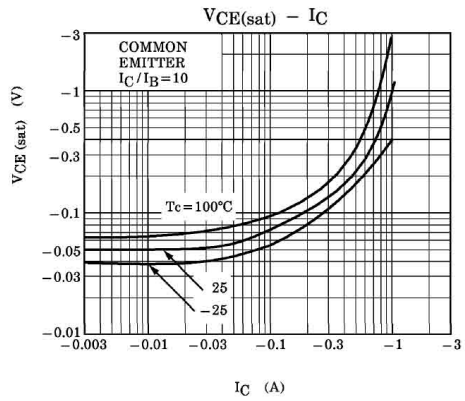
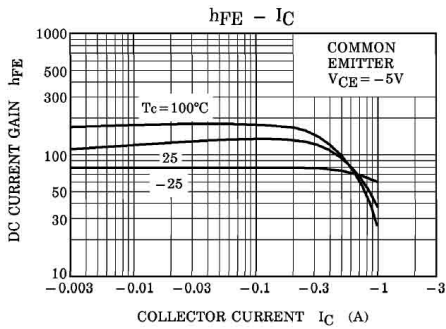
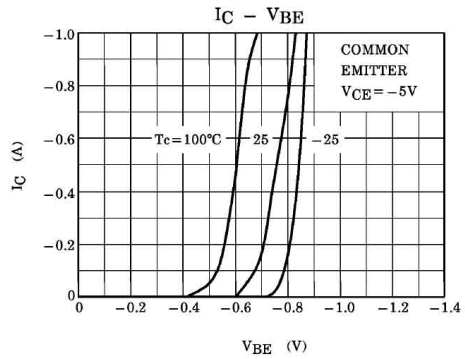
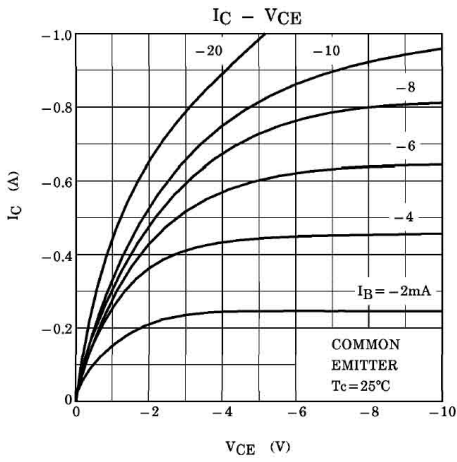
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-230	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-230	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	-5.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	-1.0	A
Base Current	I_B	-0.1	A
Collector Power Dissipation	P_C	2.0	W
	$P_{C(Tc=25^{\circ}C)}$	20	W
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	$I_C=-10mA$ $I_B=0$	-230			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=-230V$ $I_E=0$			-1.0	μA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=-5.0V$ $I_C=0$			-1.0	μA
DC Current Gain	h_{FE}	$V_{CE}=-5.0V$ $I_C=-100mA$	100		320	
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500mA$ $I_B=-50mA$			-1.5	V
Base to Emitter Voltage	V_{BE}	$V_{CE}=-5.0V$ $I_C=-500mA$			-1.0	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=-10V$ $I_C=-100mA$		70		MHz
Collector output capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=-10V$ $I_C=0$ $f=1.0MHz$		30		pF

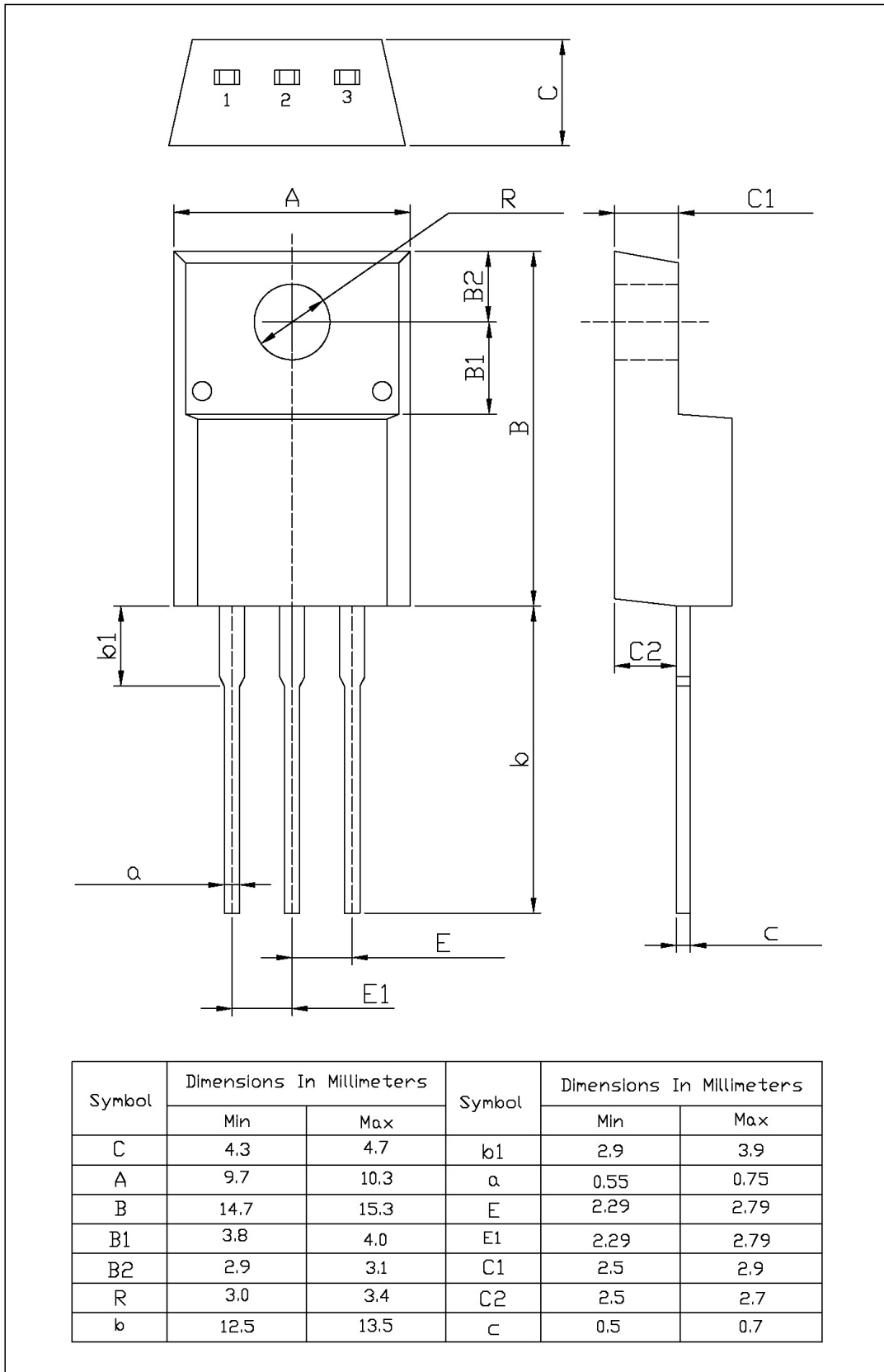
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



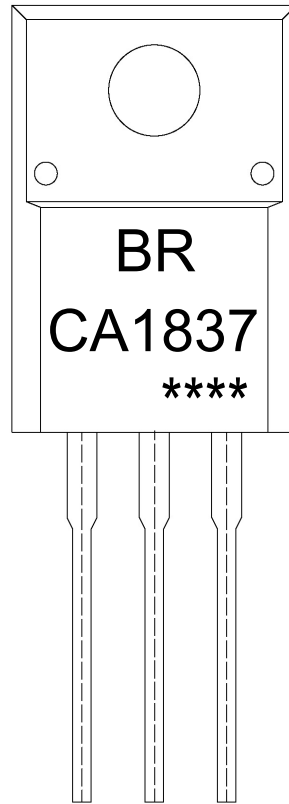
外形尺寸图 / Package Dimensions

TO-220F

单位: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

CA1837： 为型号代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

BR: Company Code.

CA1837: Product Type.

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec；
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec；
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	200	10	2,000	5	10,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):

Click to view products by [Blue Rocket manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE123AP-10](#) [NTE153MCP](#) [NTE16](#)
[NTE195A](#) [NTE92](#) [C4460](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC2712S-GR,LF](#) [2SC4731T-AY](#)
[2SC5488A-TL-H](#) [2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SD1816S-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#)
[MCH4021-TL-E](#) [MJE340](#) [US6T6TR](#) [NJL0281DG](#) [732314D](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [SZT1010T1G](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#)
[UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#) [NJL0302DG](#) [2N3583](#) [30A02MH-TL-E](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE13](#) [NTE26](#) [NTE282](#) [NTE323](#) [NTE350](#)